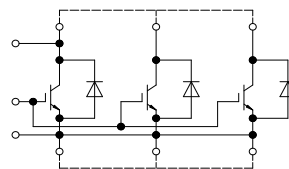


IHM-B モジュール トレンチ/フィールドストップ IGBT4 and エミッターコントロール diode内蔵
IHM-B module with Trench/Fieldstop IGBT4 and Emitter Controlled diode



external connection
(to be done)

$V_{CES} = 1700V$
 $I_{C\ nom} = 3600A / I_{CRM} = 7200A$

一般応用

- 共振型インバータアプリケーション
- ハイパワーコンバータ
- 電鉄駆動
- 風力タービン

電気的特性

- 拡張された動作温度 $T_{vj\ op}$
- 低 V_{CEsat} 飽和電圧
- 回制動作用大容量diode

機械的特性

- 4 kV AC 1分 絶縁耐圧
- サーマルサイクル耐量を増加するAlSiCベースプレート
- CTI(比較トラッキング指数) >400のモジュールパッケージ
- 長い縁面/空間距離
- 高いパワー/サーマルサイクル耐量
- 高いパワー密度
- IHM Bハウジング

Typical Applications

- Resonant inverter applications
- High power converters
- Traction drives
- Wind turbines

Electrical Features

- Extended operating temperature $T_{vj\ op}$
- Low V_{CEsat}
- Enlarged diode for regenerative operation

Mechanical Features

- 4 kV AC 1min insulation
- AlSiC base plate for increased thermal cycling capability
- Package with CTI > 400
- High creepage and clearance distances
- High power and thermal cycling capability
- High power density
- IHM B housing

Module Label Code

Barcode Code 128



DMX - Code



Content of the Code

Content of the Code	Digit
Module Serial Number	1 - 5
Module Material Number	6 - 11
Production Order Number	12 - 19
Datecode (Production Year)	20 - 21
Datecode (Production Week)	22 - 23

prepared by: WB	date of publication: 2016-01-21	
approved by: IB	revision: V3.1	UL approved (E83335)



IGBT- インバータ / IGBT, Inverter
最大定格 / Maximum Rated Values

コレクタ・エミッタ間電圧 Collector-emitter voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{CES}	1700	V
連続DCコレクタ電流 Continuous DC collector current	$T_C = 100^{\circ}\text{C}, T_{vj\max} = 175^{\circ}\text{C}$	$I_{C\text{nom}}$	3600	A
繰り返しピークコレクタ電流 Repetitive peak collector current	$t_P = 1\text{ms}$	I_{CRM}	7200	A
トータル損失 Total power dissipation	$T_C = 25^{\circ}\text{C}, T_{vj\max} = 175^{\circ}\text{C}$	P_{tot}	19,5	kW
ゲート・エミッタ間ピーク電圧 Gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/-20	V

電気的特性 / Characteristic Values

			min.	typ.	max.		
コレクタ・エミッタ間飽和電圧 Collector-emitter saturation voltage	$I_C = 3600\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$ $I_C = 3600\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$ $I_C = 3600\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$V_{CE\text{sat}}$	1,90 2,30 2,40	2,25	V V V	
ゲート・エミッタ間しきい値電圧 Gate threshold voltage	$I_C = 145\text{mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		V_{GEth}	5,20	5,80	6,40	V
ゲート電荷量 Gate charge	$V_{GE} = -15\text{V} \dots +15\text{V}$		Q_G	38,0			μC
内蔵ゲート抵抗 Internal gate resistor	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		R_{Gint}	0,54			Ω
入力容量 Input capacitance	$f = 1\text{MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}$		C_{ies}	295			nF
帰還容量 Reverse transfer capacitance	$f = 1\text{MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}$		C_{res}	9,50			nF
コレクタ・エミッタ間遮断電流 Collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 1700\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		I_{CES}			5,0	mA
ゲート・エミッタ間漏れ電流 Gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0\text{V}, V_{GE} = 20\text{V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		I_{GES}			400	nA
ターンオン遅れ時間 (誘導負荷) Turn-on delay time, inductive load	$I_C = 3600\text{A}, V_{CE} = 900\text{V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{V}$ $R_{Gon} = 0,6\Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	t_{don}	0,55 0,63 0,65			μs μs μs
ターンオン上昇時間 (誘導負荷) Rise time, inductive load	$I_C = 3600\text{A}, V_{CE} = 900\text{V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{V}$ $R_{Gon} = 0,6\Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	t_r	0,28 0,29 0,295			μs μs μs
ターンオフ遅れ時間 (誘導負荷) Turn-off delay time, inductive load	$I_C = 3600\text{A}, V_{CE} = 900\text{V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{V}$ $R_{Goff} = 0,5\Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	t_{doff}	1,60 1,70 1,75			μs μs μs
ターンオフ下降時間 (誘導負荷) Fall time, inductive load	$I_C = 3600\text{A}, V_{CE} = 900\text{V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{V}$ $R_{Goff} = 0,5\Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	t_f	0,21 0,315 0,345			μs μs μs
ターンオンスイッチング損失 Turn-on energy loss per pulse	$I_C = 3600\text{A}, V_{CE} = 900\text{V}, L_S = 50\text{nH}$ $V_{GE} = \pm 15\text{V}, di/dt = 12000\text{A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150^{\circ}\text{C})$ $R_{Gon} = 0,6\Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	E_{on}	780 980 1050			mJ mJ mJ
ターンオフスイッチング損失 Turn-off energy loss per pulse	$I_C = 3600\text{A}, V_{CE} = 900\text{V}, L_S = 50\text{nH}$ $V_{GE} = \pm 15\text{V}, du/dt = 2350\text{V}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150^{\circ}\text{C})$ $R_{Goff} = 0,5\Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	E_{off}	1200 1450 1500			mJ mJ mJ
短絡電流 SC data	$V_{GE} \leq 15\text{V}, V_{CC} = 1000\text{V}$ $V_{CE\text{max}} = V_{CES} - L_{SCE} \cdot di/dt$ $t_P \leq 10\mu\text{s}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$		I_{SC}	14000			A
ジャンクション・ケース間熱抵抗 Thermal resistance, junction to case	IGBT部 (1素子当り) / per IGBT		R_{thJC}			5,70	K/kW
ケース・ヒートシンク間熱抵抗 Thermal resistance, case to heatsink	IGBT部 (1素子当り) / per IGBT $\lambda_{\text{Paste}} = 1\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ / $\lambda_{\text{grease}} = 1\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		R_{thCH}	9,70			K/kW
動作温度 Temperature under switching conditions			$T_{vj\text{op}}$	-40		150	$^{\circ}\text{C}$

prepared by: WB	date of publication: 2016-01-21
approved by: IB	revision: V3.1



Diode、インバータ / Diode, Inverter
最大定格 / Maximum Rated Values

ピーク繰返し逆電圧 Repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{RRM}	1700	V
連続DC電流 Continuous DC forward current		I_F	3600	A
ピーク繰返し順電流 Repetitive peak forward current	$t_P = 1 \text{ ms}$	I_{FRM}	7200	A
電流二乗時間積 I^2t - value	$V_R = 0 \text{ V}, t_P = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $V_R = 0 \text{ V}, t_P = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	I^2t	2100 2000	kA^2s kA^2s
最大損失 Maximum power dissipation	$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	P_{RQM}	4900	kW
最小ターンオン時間 Minimum turn-on time		$t_{on \text{ min}}$	10,0	μs

電気的特性 / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
順電圧 Forward voltage	$I_F = 3600 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$ $I_F = 3600 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$ $I_F = 3600 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	V_F	1,65 1,65 1,65	2,10	V V V
ピーク逆回復電流 Peak reverse recovery current	$I_F = 3600 \text{ A}, -di_F/dt = 12000 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $V_R = 900 \text{ V}$ $V_{GE} = -15 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	I_{RM}	2900 3400 3650		A A A
逆回復電荷量 Recovered charge	$I_F = 3600 \text{ A}, -di_F/dt = 12000 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $V_R = 900 \text{ V}$ $V_{GE} = -15 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	Q_r	850 1550 1750		μC μC μC
逆回復損失 Reverse recovery energy	$I_F = 3600 \text{ A}, -di_F/dt = 12000 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $V_R = 900 \text{ V}$ $V_{GE} = -15 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	E_{rec}	550 1050 1250		mJ mJ mJ
ジャンクション・ケース間熱抵抗 Thermal resistance, junction to case	/Diode (1 素子当り) / per diode		R_{thJC}		8,06	K/kW
ケース・ヒートシンク間熱抵抗 Thermal resistance, case to heatsink	/Diode (1 素子当り) / per diode $\lambda_{\text{Paste}} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ / $\lambda_{\text{grease}} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		R_{thCH}		10,5	K/kW
動作温度 Temperature under switching conditions			$T_{vj \text{ op}}$	-40	150	$^{\circ}\text{C}$

prepared by: WB	date of publication: 2016-01-21
approved by: IB	revision: V3.1



モジュール / Module

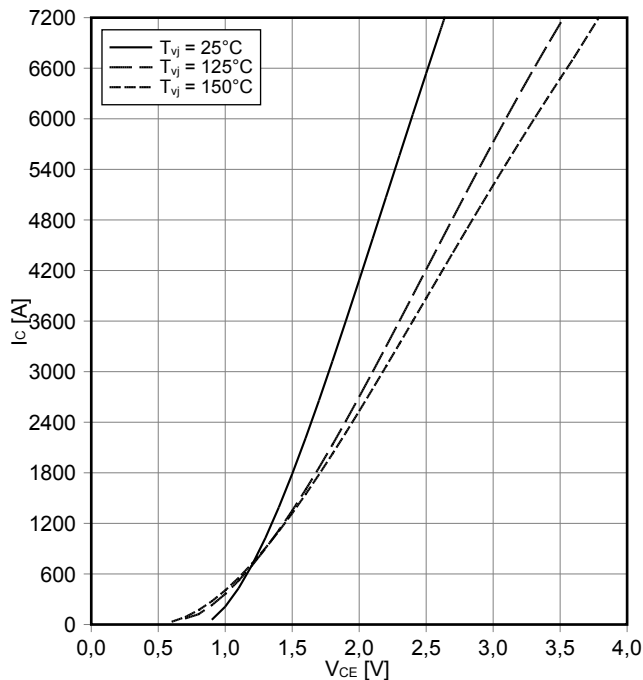
絶縁耐圧 Isolation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min.	V _{ISOL}	4,0		kV
ベースプレート材質 Material of module baseplate			AlSiC		
沿面距離 Creepage distance	連絡方法 - ヒートシンク / terminal to heatsink 連絡方法 - 連絡方法 / terminal to terminal		32,2 32,2		mm
空間距離 Clearance	連絡方法 - ヒートシンク / terminal to heatsink 連絡方法 - 連絡方法 / terminal to terminal		19,1 19,1		mm
相対トラッキング指数 Comperative tracking index		CTI	> 400		
			min.	typ.	max.
内部インダクタンス Stray inductance module		L _{sCE}		6,0	nH
パワーターミナル・チップ間抵抗 Module lead resistance, terminals - chip	T _c = 25°C, /スイッチ / per switch	R _{CC+EE'}		0,085	mΩ
保存温度 Storage temperature		T _{stg}	-40		150 °C
取り付けネジ締め付けトルク Mounting torque for modul mounting	取り付けネジ M6 適切なアプリケーションノートによるマウンティング Screw M6 - Mounting according to valid application note	M	4,25		5,75 Nm
主端子ネジ締め付けトルク Terminal connection torque	取り付けネジ M4 適切なアプリケーションノートによるマウンティング Screw M4 - Mounting according to valid application note 取り付けネジ M8 適切なアプリケーションノートによるマウンティング Screw M8 - Mounting according to valid application note	M	1,8	-	2,1 Nm
			8,0	-	10 Nm
質量 Weight		G		1200	g

prepared by: WB	date of publication: 2016-01-21
approved by: IB	revision: V3.1



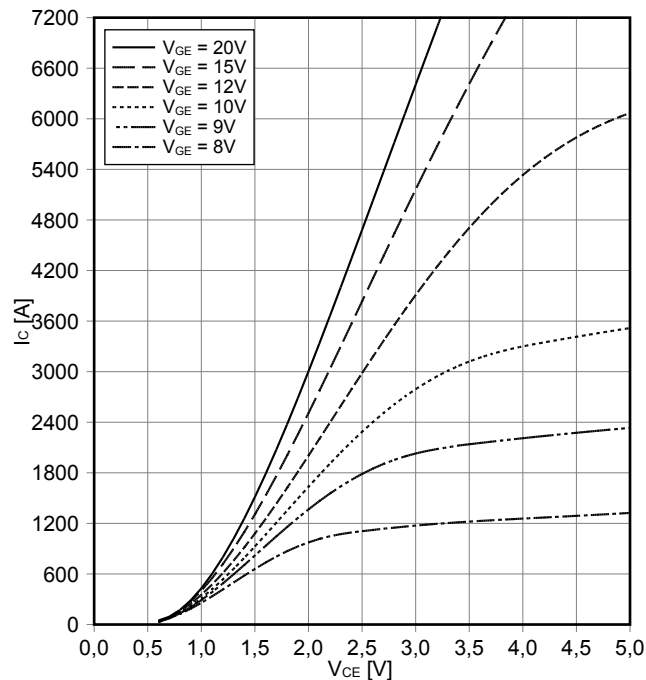
出力特性 IGBT- インバータ (Typical)
output characteristic IGBT, Inverter (typical)

$I_C = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = 15\text{ V}$



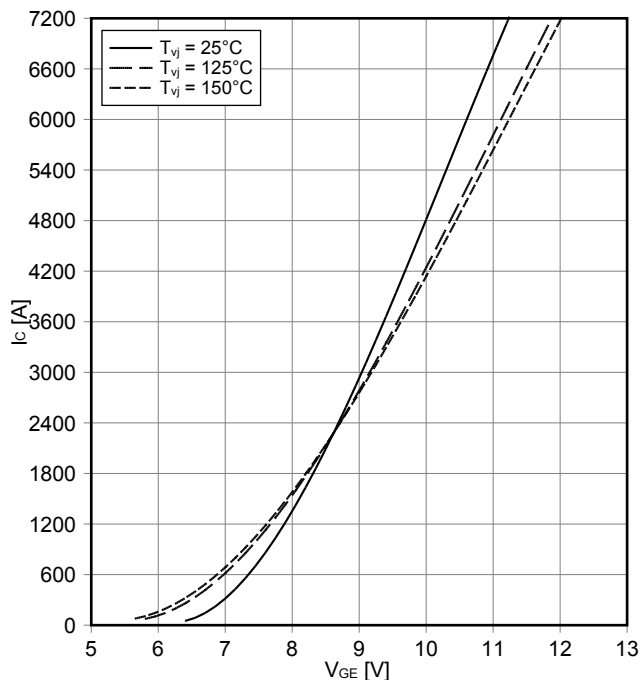
出力特性 IGBT- インバータ (Typical)
output characteristic IGBT, Inverter (typical)

$I_C = f(V_{CE})$
 $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$



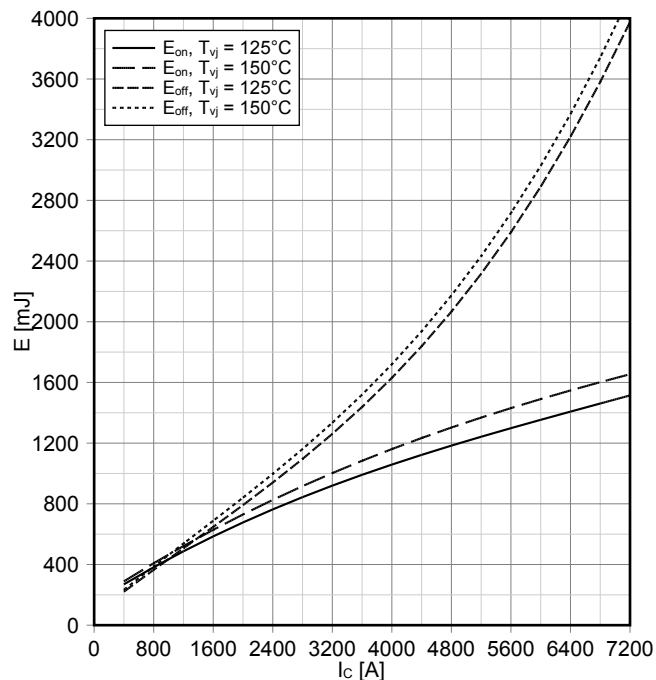
伝達特性 IGBT- インバータ (Typical)
transfer characteristic IGBT, Inverter (typical)

$I_C = f(V_{GE})$
 $V_{CE} = 20\text{ V}$



スイッチング損失 IGBT- インバータ (Typical)
switching losses IGBT, Inverter (typical)

$E_{on} = f(I_C), E_{off} = f(I_C)$
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = 0.6\ \Omega, R_{Goff} = 0.5\ \Omega, V_{CE} = 900\text{ V}$

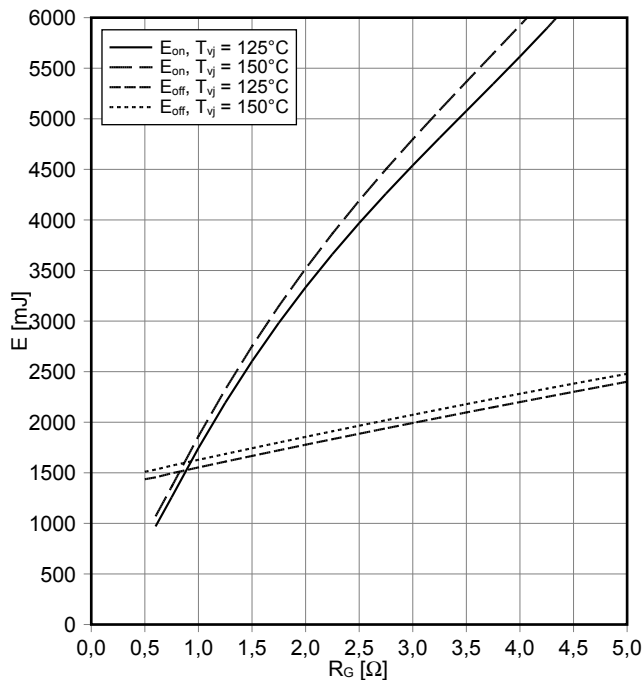


prepared by: WB	date of publication: 2016-01-21
approved by: IB	revision: V3.1



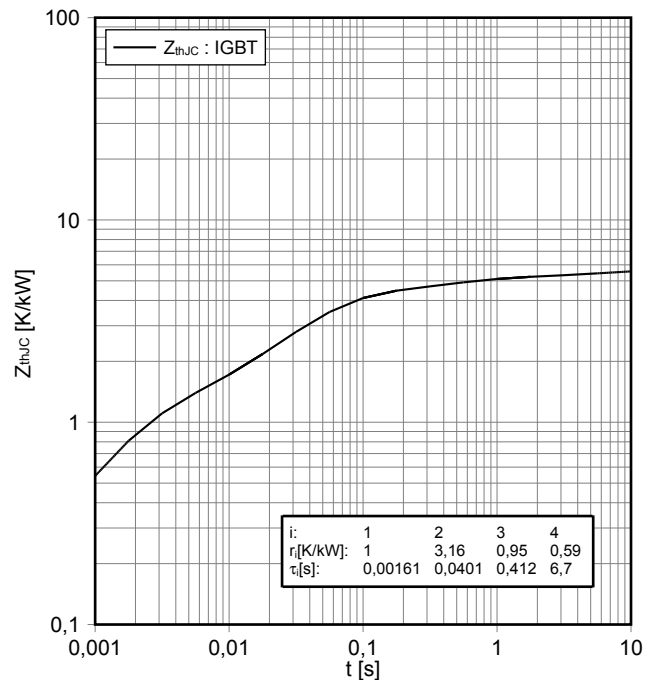
スイッチング損失 IGBT- インバータ (Typical)
switching losses IGBT, Inverter (typical)

$E_{on} = f(R_G), E_{off} = f(R_G)$
 $V_{GE} = \pm 15 V, I_C = 3600 A, V_{CE} = 900 V$



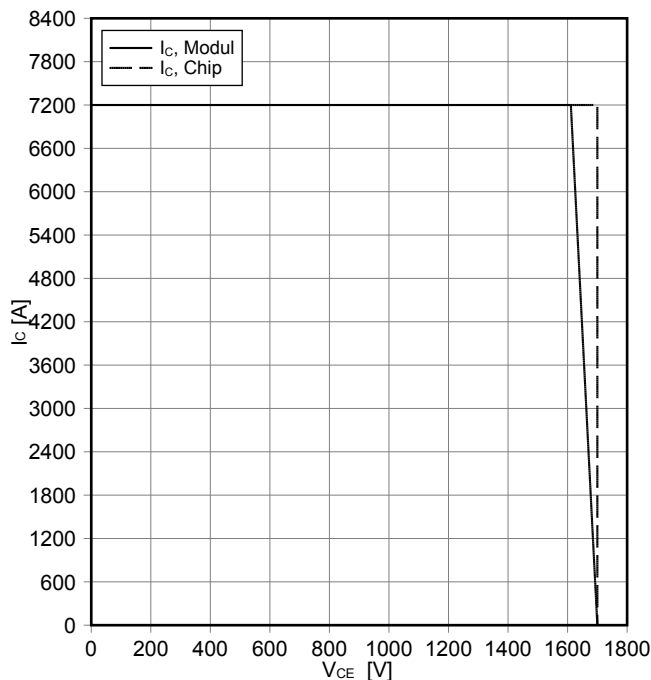
過渡熱インピーダンス IGBT- インバータ
transient thermal impedance IGBT, Inverter

$Z_{thJC} = f(t)$



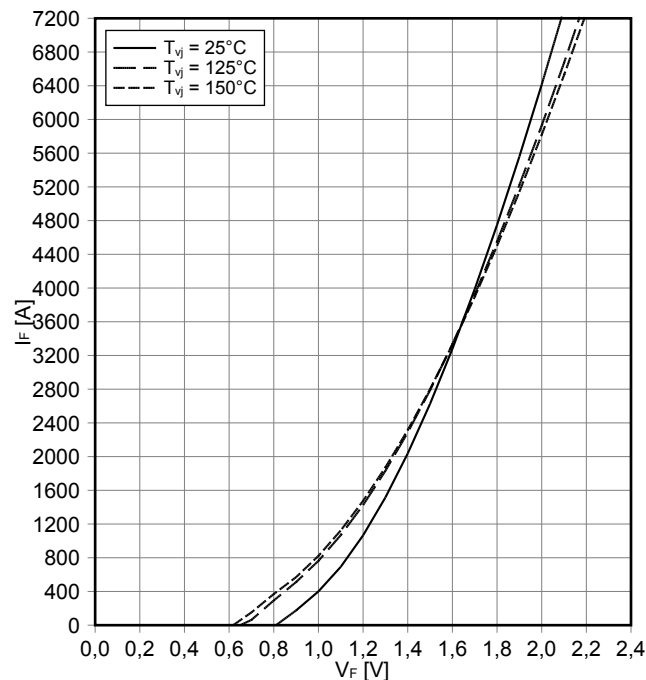
逆バイアス安全動作領域 IGBT- インバータ (RBSOA)
reverse bias safe operating area IGBT, Inverter (RBSOA)

$I_C = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = \pm 15 V, R_{Goff} = 0.5 \Omega, T_{vj} = 150^\circ C$



順電圧特性 Diode、インバータ (typical)
forward characteristic of Diode, Inverter (typical)

$I_F = f(V_F)$

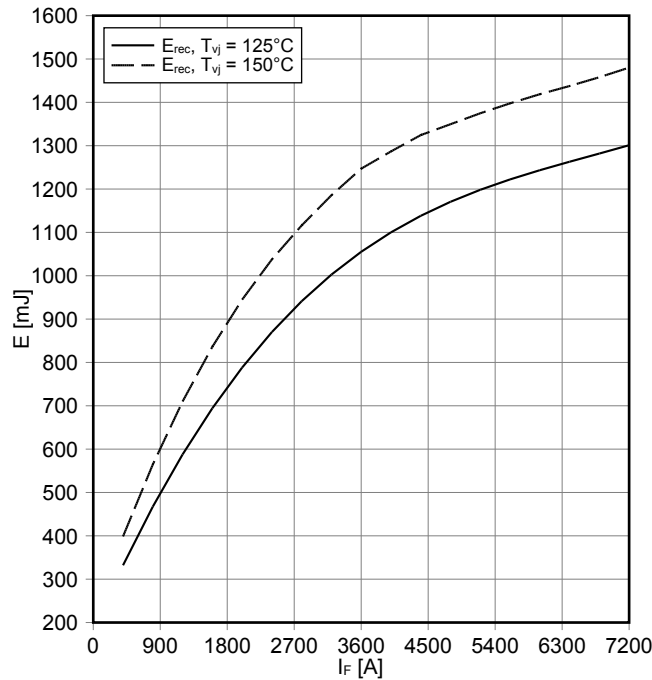


prepared by: WB	date of publication: 2016-01-21
approved by: IB	revision: V3.1



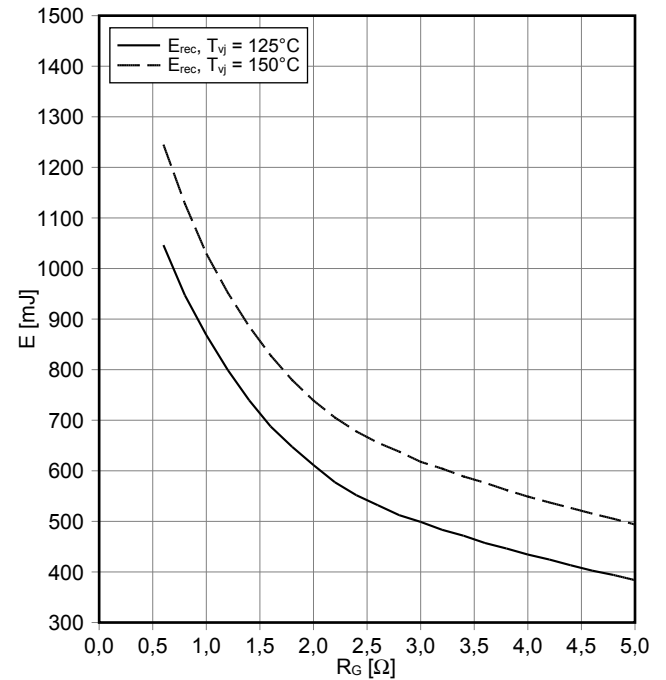
スイッチング損失 Diode、インバータ (Typical)
switching losses Diode, Inverter (typical)

$E_{rec} = f(I_F)$
 $R_{Gon} = 0.6 \Omega, V_{CE} = 900 V$



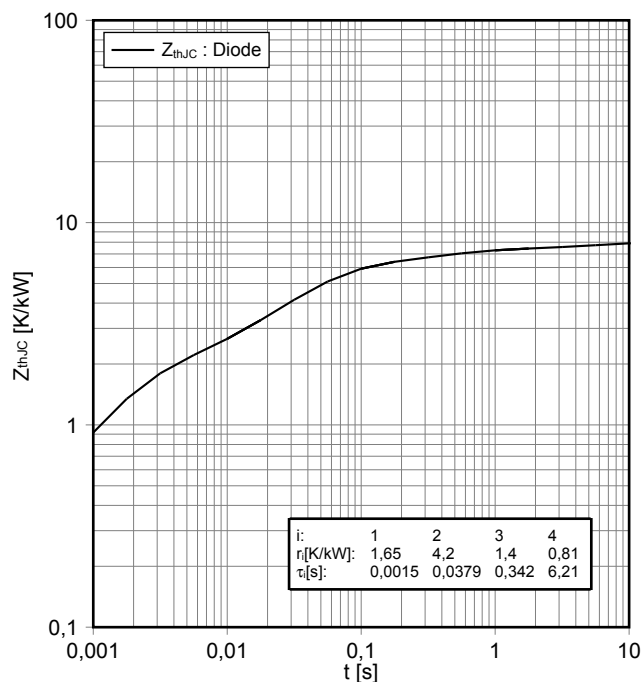
スイッチング損失 Diode、インバータ (Typical)
switching losses Diode, Inverter (typical)

$E_{rec} = f(R_G)$
 $I_F = 3600 A, V_{CE} = 900 V$



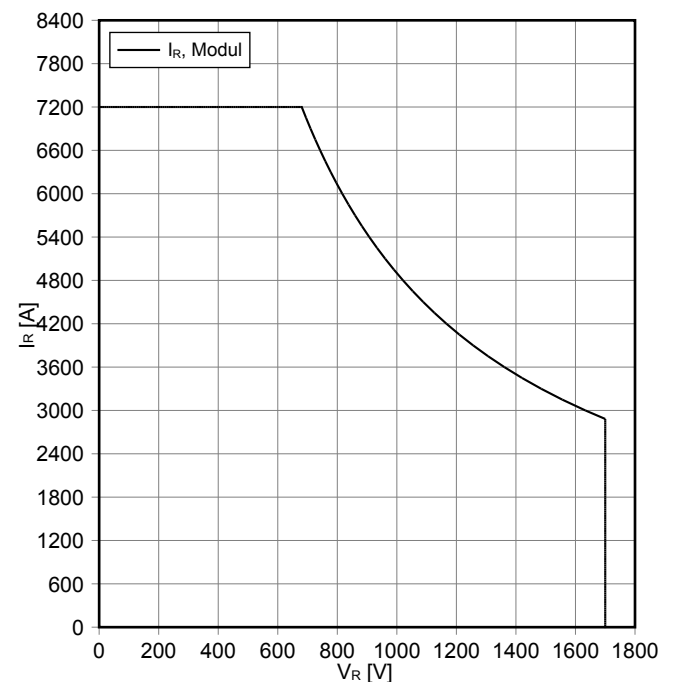
過渡熱インピーダンス Diode、インバータ
transient thermal impedance Diode, Inverter

$Z_{thJC} = f(t)$



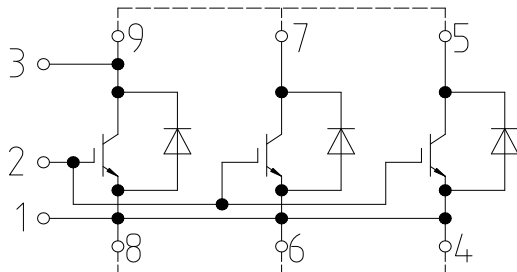
安全動作領域 Diode、インバータ (SOA)
safe operation area Diode, Inverter (SOA)

$I_R = f(V_R)$
 $T_{vj} = 150^\circ C$



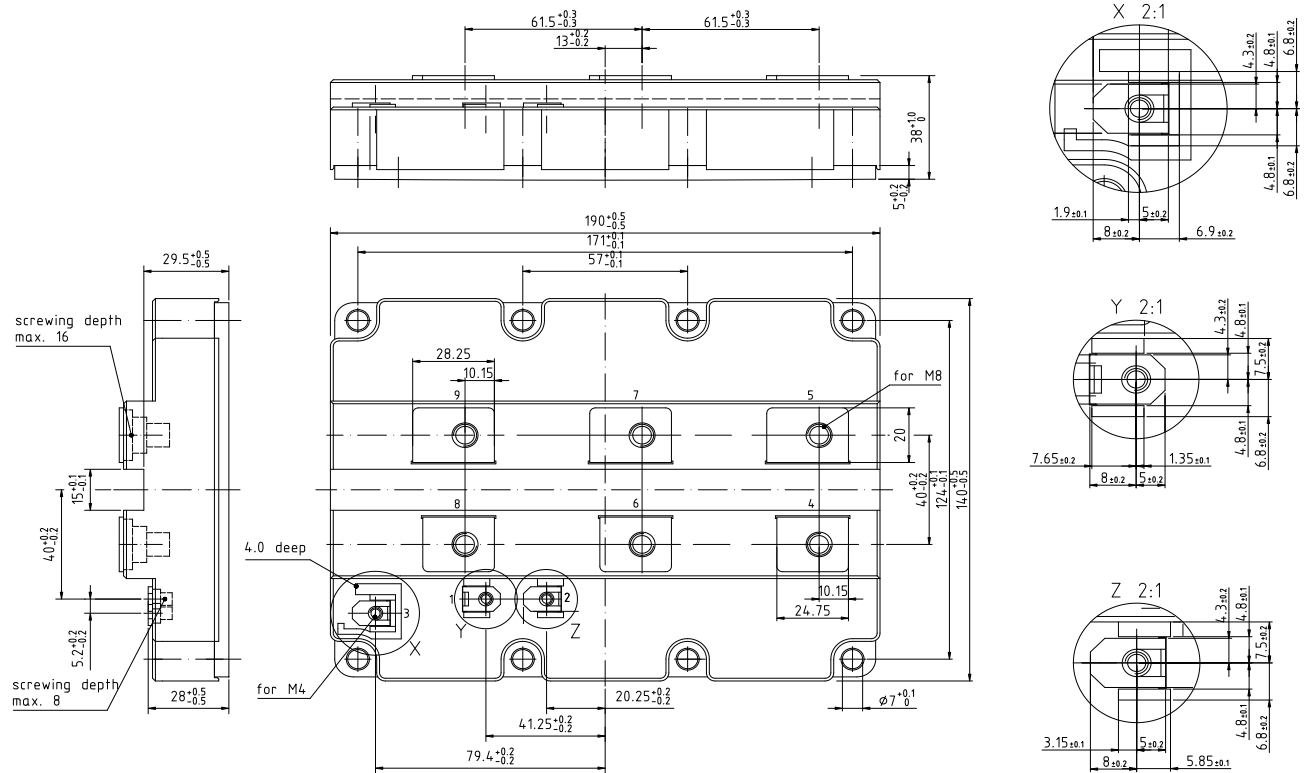
prepared by: WB	date of publication: 2016-01-21
approved by: IB	revision: V3.1

回路図 / Circuit diagram



external connection
(to be done)

パッケージ概要 / Package outlines



prepared by: WB	date of publication: 2016-01-21
approved by: IB	revision: V3.1